**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 多靶多功能溅射系统 | 台 | 1 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** | **单位** | **数量** |
| **1** | 多靶多功能溅射系统 | 1、主要用途：能够采用磁控溅射和离子束溅射制备超导、磁性材料、半导体介电材料等电子薄膜；并且能够在多种生物模板上制备具有仿生结构的功能材料。  2、系统总体要求：  系统必须具备主机结构，1套基片转动系统，2个磁控溅射靶枪，1套离子束溅射装置，1个可旋转的离子束溅射靶材固定支架，1套真空抽气系统和1套加热系统。  \*3、基片转动系统技术要求：  3.1. 工位可放置一片样品，放置最大Φ60mm样品， 基片能够正对靶面做公转运动，使基片可以实现公，转速可调，调整范围为30转/分钟～45转/分钟；(双面镀膜)  3.2. 样品转盘：加热样品转盘，转盘上有一个工位，工位安装加热炉，工位可放置一片样品，放置最大Φ60mm样品，最高加热温度为800℃；基片架可以 ± 0°～90°任意位置调整，基片角度要求在真空下可以调整。基片要求能够做自转，运动转速可调，调整范围为30转/分钟～45转/分钟。（单面镀膜）  4、磁控溅射枪技术要求：  4.1. 系统配置两个圆形磁控靶枪对向放置，磁控靶的磁钢采用钐钴，溅射枪表面磁场约为800高斯，误差≤±10%；  \*4.2. 靶材尺寸为Φ60 mm，靶电源配置两个1000 W直流电源和1个500 W射频电源，射频电源频率为13.56 MHz；  5、离子束溅射装置技术要求：  5.1. 离子能量范围300～3000 eV，离子束流范围50～150 mA；  5.2. 工作气体要求为氩气、氮气，工作范围为1×10-2 Pa~5×10-2 Pa；  5.3. 溅射区域范围为Φ30mm-Φ60 mm；  6、离子束溅射靶材固定支架技术要求：  6.1. 在样品转盘工位的下方安装一个四工位转靶，每一个工位安装一个靶材，靶材尺寸为70×70mm，转靶通水冷却，靶材平面与溅射离子枪呈45°。转靶由电机驱动转动到不同的四个工位。  6.2. 转靶挡板，转靶配有一个筒形挡板，由机械转轴驱动，手动。  7、真空系统技术要求：  7.1. 要求主泵配用涡轮分子泵，分子泵口径为160 mm，前级配用直连机械泵；  7.2. 配备高真空阀、高真空阀口径为160 mm低真空阀、予真空阀、放气阀等真空控制单元，高真空阀为手动插板阀，可通过高真空阀控制真空室压强；  7.3. 镀膜室极限真空度应不低于6×10-5Pa；  8、加热系统技术要求：  8.1基片加热器尺寸约70mm，温度可控可调，最高加热温度800 oC，要求加热温度精度为±2 oC；基片运动始终位于加热器的中部。  注：加\*指标为核心指标，必须满足。 | 台 | 1 |

**3、质保要求**

质保1年，1年后有偿服务，需提供详细的售后服务方案。

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制响应性文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。